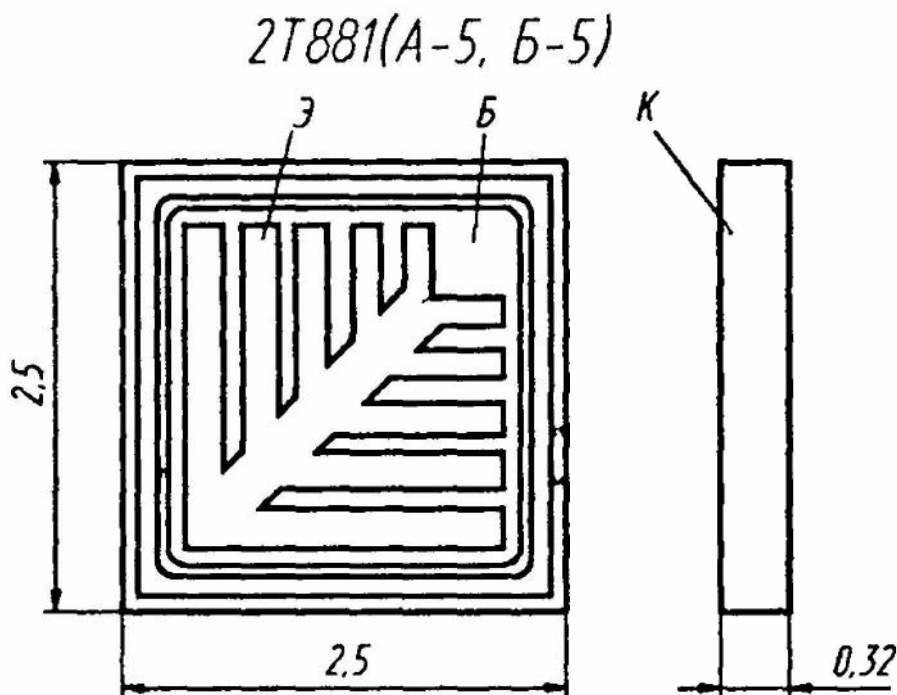
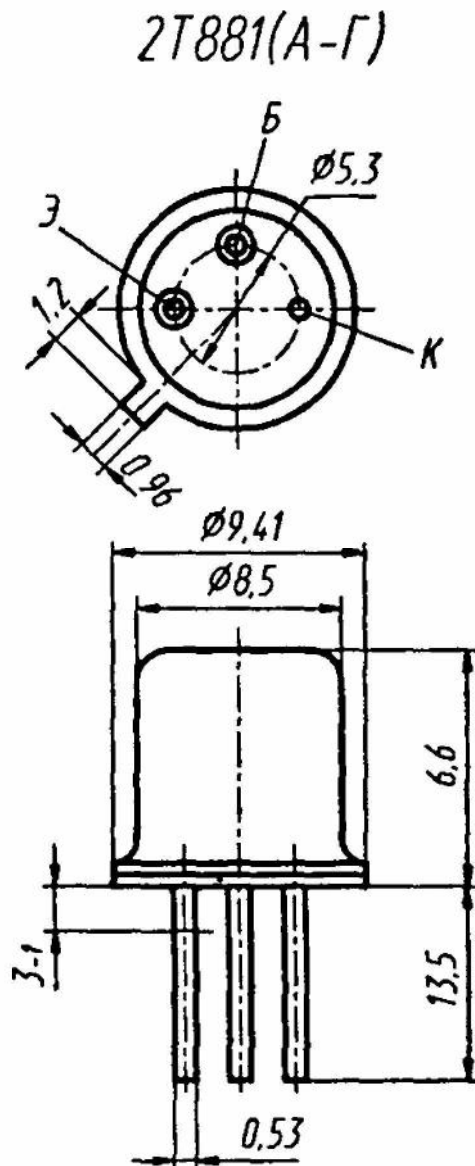


**2Т881А, 2Т881Б, 2Т881В, 2Т881Г,
2Т881А-5, 2Т881Б-5**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *п-р-п* универсальные. Предназначены для применения в усилительных и переключательных устройствах. Транзисторы 2Т881А-2Т881Г выпускаются в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Транзисторы 2Т881А-5, 2Т881Б-5 выпускаются в виде кристаллов с контактными площадками без кристаллодержателя и без выводов для гибридных интегральных микросхем. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 2 г, кристалла не более 0,01 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока

в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 1$ А:

2Т881А, 2Т881Б, 2Т881В, 2Т881А-5, 2Т881Б-5	80...250
2Т881Г	40...160

Граничная частота коэффициента передачи

тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 0,05$ А 30...300 МГц

Граничное напряжение при $I_3 = 0,03$ А,

не менее:

2Т881А, 2Т881Б, 2Т881А-5, 2Т881Б-5	60 В
2Т881В	40 В
2Т881Г	80 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при $I_К = 1$ А, $I_Б = 0,2$ А, не более 0,35 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_К = 1$ А, $I_Б = 0,2$ А, не более 1,3 В

Время включения при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_К = 1$ А,

$I_Б = 0,2$ А, типовое значение 0,08* мкс

Время выключения при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_К = 1$ А,

$I_Б = 0,2$ А, типовое значение 0,6* мкс

Время рассасывания при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_К = 1$ А,

$I_Б = 0,2$ А, типовое значение 0,5* мкс

Емкость коллекторного перехода

при $U_{КБ} = 5$ В, типовое 200* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 4$ В,

типовое значение 900* пФ

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ, \text{МАКС}}$,

не более 0,2 мА

Обратный ток коллектор—эмиттер

при $U_{КЭ} = U_{КЭ R, \text{МАКС}}$, $R_{БЭ} = 1$ кОм, не более 0,5 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

2Т881А, 2Т881Г, 2Т881А-5	100 В
2Т881Б, 2Т881Б-5	80 В
2Т881В	50 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

при $R_{БЭ} = 1$ кОм:

2Т881А, 2Т881Г, 2Т881А-5	100 В
2Т881Б, 2Т881Б-5	80 В
2Т881В	50 В

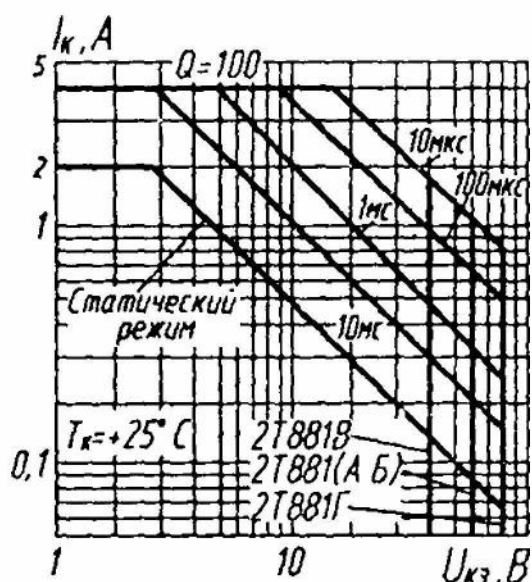
при $R_{БЭ} = \infty$:

2Т881А, 2Т881Б, 2Т881А-5, 2Т881Б-5	60 В
------------------------------------	------

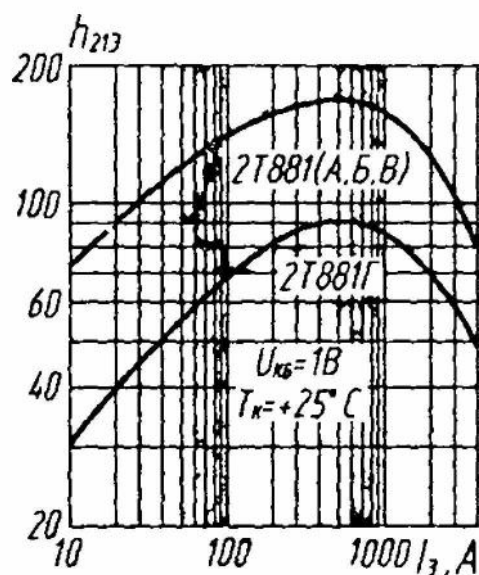
2Т881В	40 В
2Т881Г	80 В
Постоянное напряжение база—эмиттер.....	4,5 В
Постоянный ток коллектора	2 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10$ мс.....	4 А
Постоянный ток базы	1 А
Импульсный ток базы при $t_{и} = 10$ мс	1,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ¹ при $T_{к} = -60...+25$ °С:	
с теплоотводом	5 Вт
без теплоотвода	0,8 Вт
Температура р-п перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-60... $T_{к} =$ = +125 °С

¹ При $T_{к} = +25...+125$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность снижается линейно на 0,04 Вт/°С с теплоотводом и на 6,4 мВт/°С без теплоотвода.

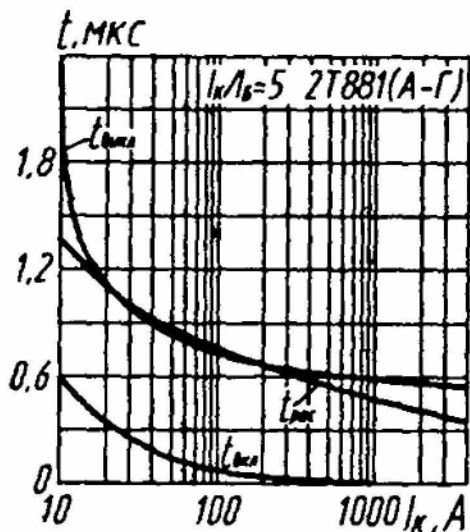
Зависимости электрических параметров 2Т881А–5, 2Т881Б–5 аналогичны зависимостям 2Т881А, 2Т881Б.



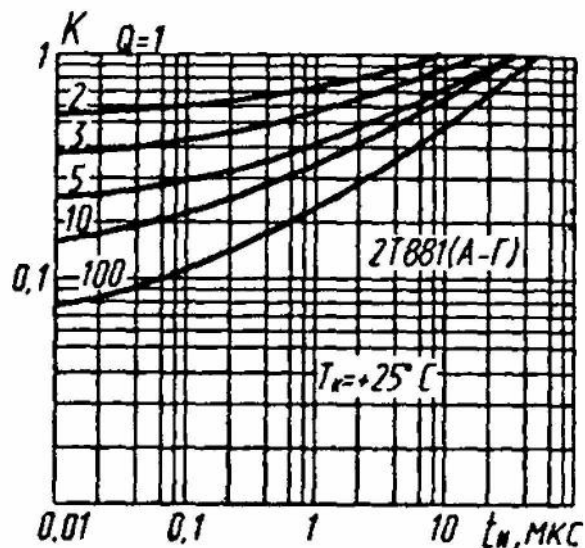
Области безопасной работы транзисторов



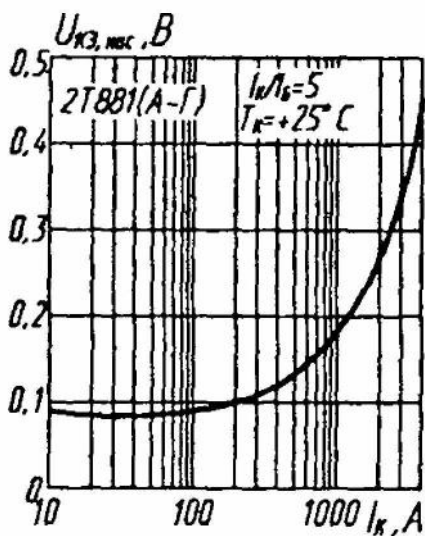
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



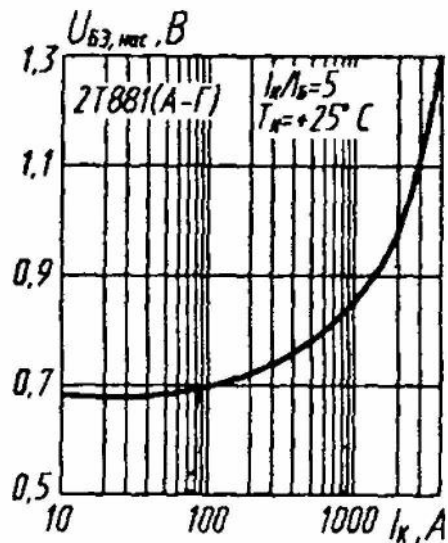
Зависимости времени включения, выключения и рассасывания от тока коллектора



Зависимости коэффициента K от длительности импульса



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора